Catálogo de produtos

Amplificadores de potência GaN

Amplificadores de potência GaN usam dispositivos de nitreto de gálio no estágio RF. Polarização, caminho térmico, forma de onda e carga determinam a saída útil do amplificador completo.



Produtos: 18

Revisão: 14 · Data da revisão: 2026-11-12



LCPAM-2000-6000-100-485

Módulo amplificador de potência RF GaN de banda larga, 2–6 GHz, 100 W

O LCPAM-2000-6000-100-485 é um módulo amplificador RF de alta potência e banda larga com tecnologia GaN para 2–6 GHz. A potência de saída saturada típica é de 100 W, com ganho típico de 50 dB. Opera com 24–32 VDC e inclui interface RS-485, monitoramento de estado e desligamento de proteção. Pode ser avaliado como estágio de potência em sistemas RF de 50 Ω.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidade: MHz

Potência RF de saída saturada: Símbolo: Pout; Típico: 100; Unidade: W

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 50; Unidade: dB

Tensão de operação: Símbolo: VDC; Mínimo: 24; Típico: 28; Máximo: 32; Unidade: VDC

Salvo indicação em contrário: +28,0 VDC, 25 °C, sistema de 50 Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-100-18000-5

Amplificador de potência GaN RF de 100–18000 MHz, mínimo de 5 W

O amplificador GaN cobre 100–18000 MHz com saída saturada mínima de 5 W e típica de 7 W. O ganho é mínimo de 37 dB e típico de 38 dB, com planicidade típica de ±0.5 dB.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 100; Máximo: 18000; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 5; Típico: 7; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 37; Típico: 38; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-10700-12700-100

Amplificador de potência GaN RF de 10700–12700 MHz, típico de 100 W

O amplificador GaN cobre 10700–12700 MHz com saída saturada típica de 100 W e ganho típico de 50 dB. A planicidade típica é ±1 dB, com harmônicos típicos −50 dBc a 100 W de saída.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 10700; Máximo: 12700; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 100; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Típico: 50; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω. Confirme com a LCRF a corrente de operação e a atuação da proteção contra sobrecorrente antes de dimensionar a fonte de alimentação.

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-10700-12700-50

Amplificador de potência GaN RF de 10700–12700 MHz, típico de 50 W

O amplificador GaN fornece saída saturada típica de 50 W em 10700–12700 MHz e ganho típico de 47 dB. A corrente dinâmica típica é 10 A a 50 W, com corrente de repouso típica de 1.6 A.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 10700; Máximo: 12700; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 50; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Típico: 47; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-10700-12750-100

Amplificador GaN RF de 10700–12750 MHz, típico de 100 W, adaptador WR75

O amplificador GaN cobre 10700–12750 MHz com saída saturada típica de 100 W e ganho mínimo de 50 dB. A saída típica na compressão de 1 dB é 40 W; a corrente típica é 21 A a 100 W.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 10700; Máximo: 12750; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P-1dB; Típico: 40; Unidade: W

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 100; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 50; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-2000-6000-20

Amplificador GaN RF de 2000–6000 MHz, saída saturada típica de 25 W

A ficha deste modelo especifica saída saturada típica de 25 W em 2000–6000 MHz e ganho típico de 44 dB. A corrente típica de 2.5 A e a eficiência de potência adicionada de 30% são ambas especificadas a 20 W de saída.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 25; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Típico: 44; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-3000-8000-100-485

Amplificador de potência GaN RF de 3000–8000 MHz, típico de 100 W, RS-485

O amplificador GaN cobre 3000–8000 MHz com saída saturada mínima de 80 W e típica de 100 W. O ganho é mínimo de 49 dB e típico de 50 dB; a corrente típica é 18 A a 100 W de saída.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 3000; Máximo: 8000; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 80; Típico: 100; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 49; Típico: 50; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±2; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-30-1000-10

Amplificador de potência GaN RF de 30–1000 MHz, típico de 10 W

O amplificador GaN cobre 30–1000 MHz com saída saturada mínima de 9 W e típica de 10 W. O ganho típico é 40 dB com planicidade ±1 dB; a corrente típica é 0.6 A a 10 W de saída.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 30; Máximo: 1000; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 9; Típico: 10; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Típico: 40; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-30-1500-1

Amplificador de potência GaN RF de 30–1500 MHz, mínimo de 1 W

O módulo especifica saída saturada mínima de 1 W e ganho mínimo de 30 dB em 30–1500 MHz. A corrente típica é 0.15 A a 1 W, com planicidade típica de ganho de ±1 dB.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 30; Máximo: 1500; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 1; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 30; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-30-2000-1

Amplificador de potência GaN RF de 30–2000 MHz, mínimo de 1 W

Este modelo cobre 30–2000 MHz conforme a tabela elétrica, com saída saturada mínima de 1 W e ganho mínimo de 30 dB. Os harmônicos típicos são −12 dBc a 1 W e os sinais espúrios típicos −60 dBc em saturação.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 30; Máximo: 2000; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 1; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 30; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-5000-6000-100

Módulo amplificador de potência RF GaN, 5–6 GHz, ≥100 W

LCPAM-5000-6000-100 é especificado para saída saturada mínima de 100 W e ganho mínimo de 50 dB em PSAT na faixa de 5–6 GHz, a 28 VDC, 25 °C e 50 Ω.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Unidade: MHz

Potência RF de saída saturada: Símbolo: PSAT; Mínimo: 100; Unidade: W; PSAT

Ganho de potência (PSAT): Símbolo: Gp; Mínimo: 50; Unidade: dB; PSAT

Planicidade do ganho de potência (PSAT): Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidade: dB; PSAT

28 VDC; 25 °C; 50 Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-5000-8500-25

Amplificador de potência GaN RF de 5000–8500 MHz, típico de 25 W

O amplificador GaN cobre 5000–8500 MHz com saída saturada mínima de 20 W e típica de 25 W. O ganho é mínimo de 43 dB e típico de 44 dB; os harmônicos típicos são −40 dBc a 20 W.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 5000; Máximo: 8500; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 20; Típico: 25; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 43; Típico: 44; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-500-2500-100A

Amplificador de potência GaN RF de 500–2500 MHz, típico de 100 W, variante A

A variante A GaN cobre 500–2500 MHz com saída saturada típica de 100 W e ganho típico de 50 dB. A corrente típica é 12 A a 100 W; a medição de harmônicos mantém a condição de saída a 70 W.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 500; Máximo: 2500; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 100; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Típico: 50; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±2; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω A tabela elétrica informa 26 VDC mínimo, 28 VDC típico e 30 VDC máximo, enquanto a linha A1 VDD informa 28–32 VDC. A alegação de faixa para A1 não é publicada. Confirme a faixa permitida e a ligação de A1 antes de alimentar; 32 VDC não é aqui um máximo operacional aceito.

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-6000-8500-20

Amplificador de potência GaN RF de 6000–8500 MHz, mínimo de 20 W

A ficha deste modelo especifica saída saturada mínima de 20 W e típica de 25 W em 6000–8500 MHz. A corrente típica de 2.5 A e eficiência de potência adicionada de 30% aplicam-se a 20 W; a corrente de repouso típica é 1.8 A.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 6000; Máximo: 8500; Unidade: MHz

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 20; Típico: 25; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 43; Típico: 44; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-6000-8500-25

Amplificador de potência GaN RF de 6000–8500 MHz, típico de 25 W

Este modelo especifica saída saturada típica de 25 W e mínima de 20 W em 6000–8500 MHz. O ganho é típico de 44 dB e mínimo de 43 dB, com planicidade típica de ±0.5 dB.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 6000; Máximo: 8500; Unidade: MHz

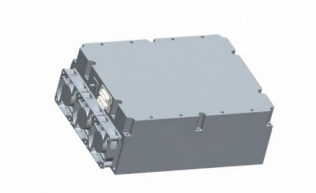
Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 20; Típico: 25; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 43; Típico: 44; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAM-8000-12000-100

Amplificador de potência GaN RF de 8000–12000 MHz, típico de 100 W

O amplificador GaN cobre 8000–12000 MHz com saída saturada típica de 100 W e ganho mínimo de 53 dB. A saída típica na compressão de 1 dB é 20 W, com planicidade típica de ±1.5 dB.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P-1dB; Típico: 20; Unidade: W

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 100; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 53; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAS-8000-12000-200

Sistema amplificador de potência GaN RF de 8000–12000 MHz, típico de 200 W

O sistema GaN cobre 8000–12000 MHz com saída saturada típica de 200 W e saída típica de 40 W na compressão de 1 dB. O ganho é mínimo de 53 dB com planicidade típica de ±1.5 dB.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P-1dB; Típico: 40; Unidade: W

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 200; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 53; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCPAS-8000-12000-400

Sistema amplificador de potência GaN RF de 8000–12000 MHz, típico de 400 W

O sistema GaN especifica saída saturada típica de 400 W em 8000–12000 MHz e saída típica de 120 W na compressão de 1 dB. O ganho é mínimo de 56 dB com planicidade típica de ±1.5 dB.

Frequência de operação: Símbolo: BW; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P-1dB; Típico: 120; Unidade: W

Potência de saída RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 400; Unidade: W

Ganho de potência @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 56; Unidade: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalhes do produto Ficha técnica do produto

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.